

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- 高耐圧 High Voltage
- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- ASO が広い Excellent Safe Operating Area
- 絶縁形 Insulated Type

■用途：Applications

- 大電力スイッチング Power Switching
- AC モータ制御 A.C Motor Controls
- DC モータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items		Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧		V _{CBO}	1000	V
コレクタ・エミッタ間電圧		V _{CEO}	1000	V
コレクタ・エミッタ間電圧		V _{CEO(SUS)}	800	V
エミッタ・ベース間電圧		V _{EB0}	10	V
コレクタ電流	DC	I _c	75	A
	1ms	I _{CP}	150	A
	DC	-I _c	75	A
ベース電流	DC	I _B	4	A
	1ms	I _{BP}	8	A
	one Transistor	P _C	500	W
コレクタ損失	two Transistors	P _C	1000	W
	接 合 部	T _j	+150	°C
保 存 温 度		T _{stg}	-40~+125	°C
重 量		m	265	g
絶 縁 耐 圧	AC. 1min	V _{iso}	2500	V
締 付 け ト ル ク		Mounting ※1	35	kg・cm
		Terminals ※1	35	kg・cm

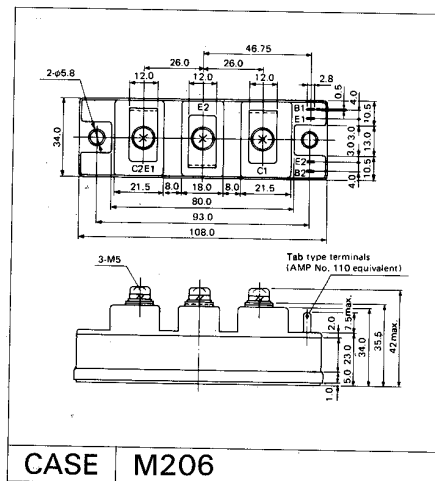
●電氣的特性：Electrical Characteristics (Tj=25°C)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	$I_{CB0}=1mA$	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	$I_C=1mA$	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	$I_C=5A$	800			V
	$V_{CEX(SUS)}$	$I_C=52.5A$	1000			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	$I_{EB0}=200mA$	10			V
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB0}=1000V$			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB0}=10V$			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=75A$			1.8	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$I_C=75A, V_{CE}=5V$	100			—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=75A, I_B=1.5A$			2.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				3.5	V
スイッチング時間	t_{on}	$I_C=75A$			2.5	μS
	t_{stg}				15.0	μS
	t_f				3.0	μS
逆回復時間	t_{rr}	$-I_C=75A, V_{BE}=-6V, -di/dt=75A/\mu S$			0.5	μS

●熱的特性：Thermal Characteristics

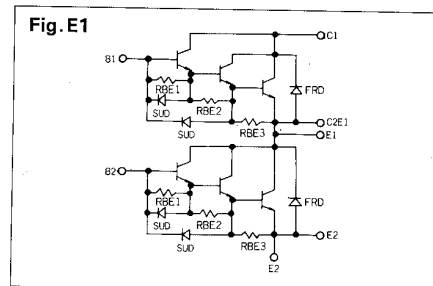
Items			Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱	抵	抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.25	°C/W
熱	抵	抗	$R_{th(j-c)}$	Diode			0.6	°C/W
熱	抵	抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.06		°C/W

■外形寸法：Outline Drawings



■等価回路

Equivalent Circuit Schematic



Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value;
M5: 25~30 kg・cm